

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成27年11月12日(2015.11.12)

【公表番号】特表2015-501374(P2015-501374A)

【公表日】平成27年1月15日(2015.1.15)

【年通号数】公開・登録公報2015-003

【出願番号】特願2014-535741(P2014-535741)

【国際特許分類】

C 2 5 B	9/10	(2006.01)
B 0 1 J	37/02	(2006.01)
H 0 1 M	4/86	(2006.01)
H 0 1 M	4/92	(2006.01)
B 0 1 J	23/46	(2006.01)
B 0 1 J	37/06	(2006.01)
B 0 1 J	37/34	(2006.01)
B 0 1 J	37/08	(2006.01)
C 2 3 C	14/14	(2006.01)
C 2 5 B	1/10	(2006.01)
C 2 5 B	11/08	(2006.01)
H 0 1 M	8/10	(2006.01)

【F I】

C 2 5 B	11/20	
B 0 1 J	37/02	3 0 1 P
H 0 1 M	4/86	M
H 0 1 M	4/92	
B 0 1 J	23/46	3 0 1 M
B 0 1 J	37/06	
B 0 1 J	37/34	
B 0 1 J	23/46	M
B 0 1 J	37/08	
C 2 3 C	14/14	G
C 2 5 B	1/10	
C 2 5 B	11/08	Z
H 0 1 M	8/10	

【手続補正書】

【提出日】平成27年9月18日(2015.9.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

触媒電極を作製する方法であって：

少なくともPt及びIrをナノ構造化ホイスカー上にスパッタリングし、Pt及びIrをそれぞれ任意の順序で含む複数の交互層を提供する工程、及び

Pt及びIrをそれぞれ含む前記複数の交互層の少なくとも一部を、少なくとも部分的に、少なくとも2kPaの絶対酸素分圧の酸素を含む雰囲気中で、ラジエーションアニー

リングする工程、
を含む、方法。

【請求項 2】

前記ラジエーションアニーリングする工程が、少なくとも 20 mJ/mm^2 の入射エネルギー・フルエンスで、少なくとも部分的に行われ、かつ、前記 P_t 及び前記 I_r が、 $10 : 1 \sim 1 : 10$ の範囲の原子比で存在する、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

触媒電極を作製する方法であって：

少なくとも P_t 及び I_r をナノ構造化ホイスカー上にスパッタリングして、 P_t 及び I_r をそれぞれ任意の順序で含む複数の交互層を提供する工程であって、前記複数の交互層の少なくとも一部分が、20 オングストローム以下の厚さである、工程を含む、方法。

【請求項 4】

触媒電極を作製する方法であって：

少なくとも P_t 、 I_r 、及び R_u をナノ構造化ホイスカー上にスパッタリングして、 P_t 、 I_r 、及び R_u をそれぞれ任意の順序で含む複数の交互層を提供する工程を含む、方法。